Tom 91

1990

Nº 5

**ФИЗНКА** 

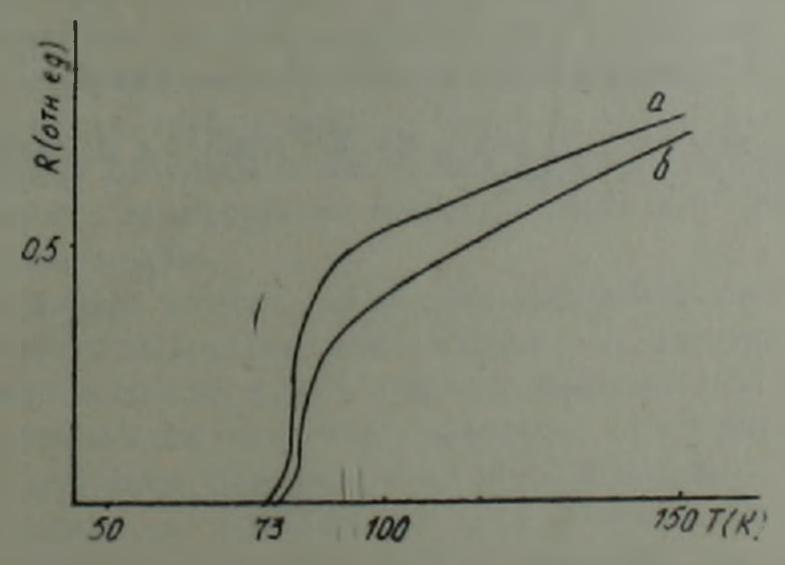
УДК 538 945 539.231

## С. Х Пилосян

## In situ-напыление Bi-подержащих пленок высокотемпературных сверхпроводников

(Представлено академиком АН Армении М. Л. Тер-Микаеляном 28/IX 1990)

1. Для решения важных в практическом отношении технологических задач необходимо понижение максимальной температуры термообработки при напылении пленок высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП). Одним из способов достижения этой цели является так называемое in situ-напыление, когда процесс кристаллизации совмещен с процессом напыления. Дополнительным преимуществом этого метода является достижимость монокристаллического характера получаемых пленок при таком процессе. Одновременно сокращается время изготовления, что позволяет уменьшить влияние диффузионных процессев и использовать более широкий спектр подложек.



Результаты резистивного контроля сверхпооволящего перехода:

а — на подложке MgO; о — на подложке Z ∪2

2. Нами использовалась лазерная напылительная установка с автоматическим заданием и контролем режима термообработки (подробно она описана в (1). Режим напыления был голобран следующим образом: напыление велось при 7 ~ 760°C и давлении всздуха в камере  $p \sim 10^{-1}$  атм, подавалось около  $10^4$  лазерных импульсов с энертией  $\sim 0.05$  Дж. Охлаждение пленки проводили со скоростью  $\sim 50^\circ$ /мин. Результаты резистивного контроля сверхпроводящего перехода показаны на рисунке.

3. Пленки внешне характеризовались повышенной (по сравнению с обычным способом получения (1 2)) зеркальностью, однородностью с толщиной 0,5<sup>-1</sup> мкм. Особенно важно отметить значительно лучшую (по сравнению с (1, 2) адгезию пленки, которая расширяет возможности се использования в прикладных целях.

Автор выражает благодарность А. М. Гуляну, А. С. Кузаняну, В. Г. Татояну за помощь в работе.

Институт фязических исследований Академии наук Армении

## Ս. ե. ՓԻԼՈՍՅԱՆ

Bi-պատունակող բատձատեսաստինանային գետնաղոտրիչ թաղանթնետի in situ-փոշենստեցնումը

In situ-փոշենստեցնումով սինթեզվել է Bi-պարունակող բարձրջերմաստիճանային գերհաղորդիչ թաղանթ։ Մեթոդր հնարավորություն է տալիս արագացնել սինթեզը, որը ընդլայնում է որպես հենք օգտագործվող նյութերի սպեկտրը։ Ի տարբևրություն սովորական մեթոդով ստացված թաղանթների, այս թաղանթները ավելի համասեռ են, ունեն հայելային անդրադարձում, լավ ադգեզիա ու բարձր միաբյուրեղություն։

## ЛИТЕРАТУРА — ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1 С Х. Пилосян, СФХТ, т. 3, № 4, с. 689—692 (1990). 2 А. А. Авагян н др., СФХТ, 1990, т. 3. № 1. с. 93—97 (1990).